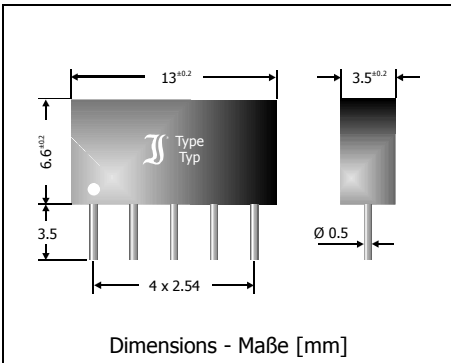
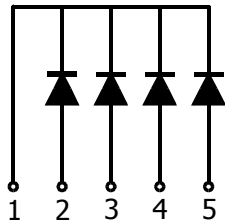


DAN401 / DAP401 (200 mW)
Small Signal Diode Arrays
Diodensätze mit Allzweckdioden

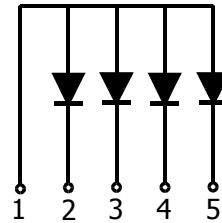
Version 2008-04-15



| | |
|---|---------------------|
| Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung | 200 mW |
| Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung | 80 V |
| 5-pin Plastic case 5-Pin Kunststoffgehäuse | 13 x 3.5 x 6.6 [mm] |
| Weight approx. – Gewicht ca. | 0.7 g |
| Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton | |



“DAN” common cathodes / gemeinsame Kathoden



“DAP” common anodes / gemeinsame Anoden

Maximum ratings

Grenzwerte

| Type Typ | Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] ¹⁾ | Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] ¹⁾ |
|-------------|--|---|
| DAN401 | 80 | 80 |
| DAP401 | 80 | 80 |

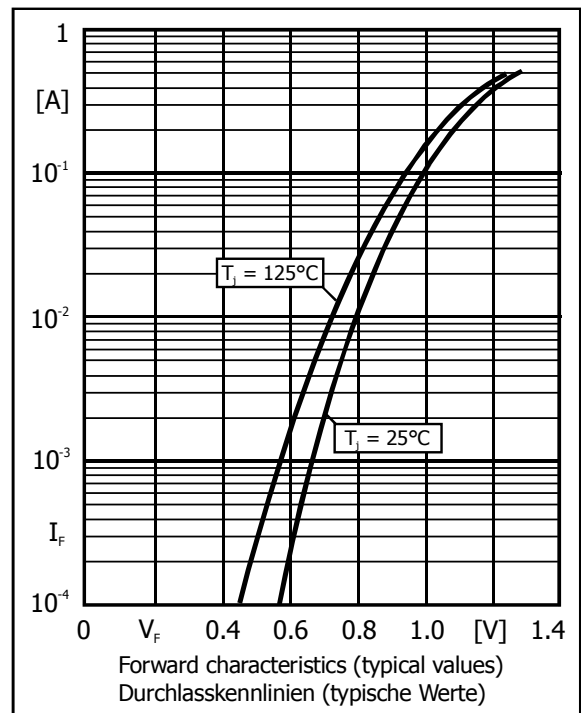
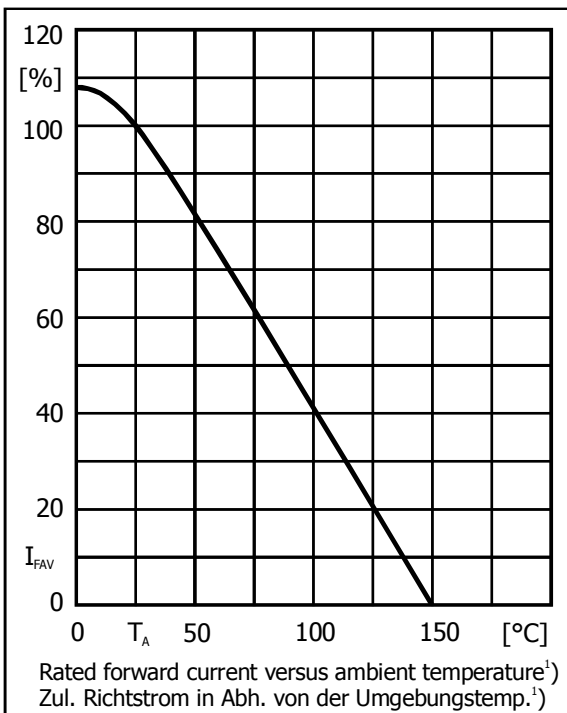
| | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------------|---|
| Max. average forward rectified current, R-load for one diode operation only for simultaneous operation | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | | I_{FAV} I_{FAV} | 100 mA ²⁾ 50 mA ²⁾ |
| Dauergrenzstrom in Einwegschtaltung mit R-Last für eine einzelne Diode bei gleichzeitigem Betrieb beider Dioden | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | | I_{FAV} I_{FAV} | 100 mA ²⁾ 50 mA ²⁾ |
| Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | | I_{FSM} | 500 mA |
| Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur | | | T_j T_s | -50...+150°C -50...+150°C |

1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

| | | | |
|---|---|-----------|-----------------------|
| Forward voltage Durchlass-Spannung | $T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 10 \text{ mA}$ | V_F | $< 1.0 \text{ V}^1)$ |
| Leakage current Sperrstrom | $T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 20 \text{ V}$ | I_R | $< 25 \text{ nA}$ |
| Reverse recovery time Sperrverzug | $I_F = 10 \text{ mA}$ through/über $I_R = 10 \text{ mA}$ to $I_R = 1 \text{ mA}$ | t_{rr} | $< 4 \text{ ns}$ |
| Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse | | R_{thc} | $< 85 \text{ K/W}^2)$ |



1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden